

- ◆电通量
 - 电场线模型
 - 电通量的定义
- ◆高斯定理
 - 定义
 - 应用: 求对称性电场的场强

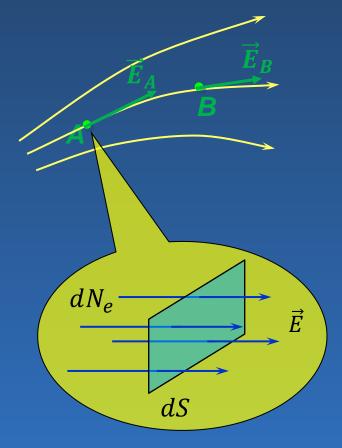
一、电场线模型

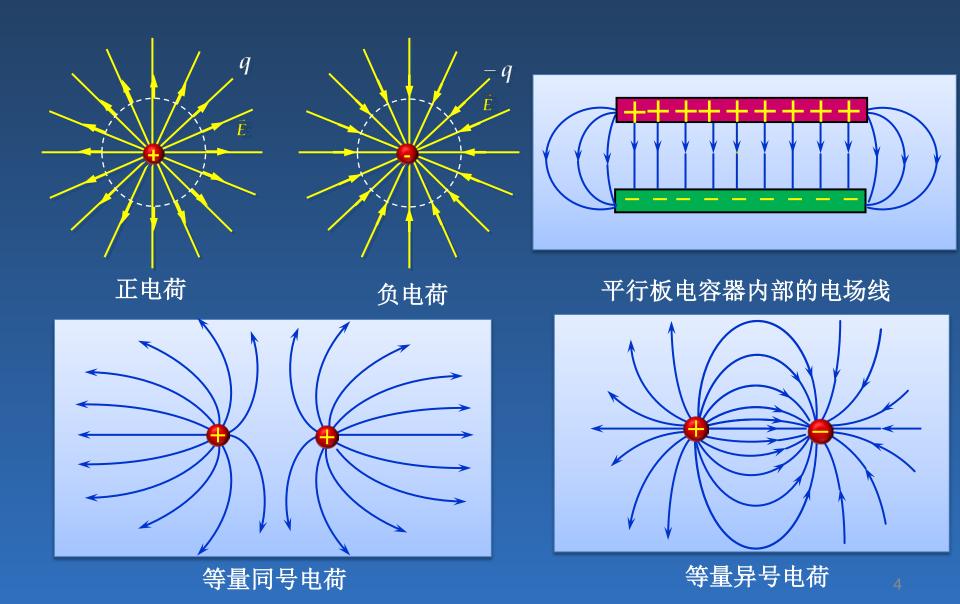
方向: 电场线上任一点的切线方向为该点的 \vec{E} 方向。

大小: 在电场中任一点,取垂直于该 点场强方向的面积元dS,通过 面积元dS的电场线数dN_e与面 积元dS的比值,为电场线密度 也就是该点的产大小。

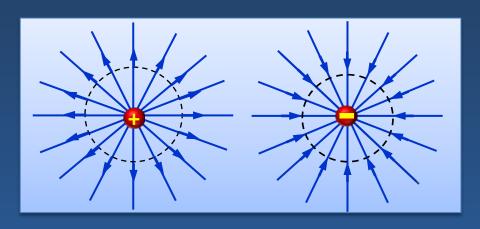
$$E = \frac{dN_e}{dS}$$

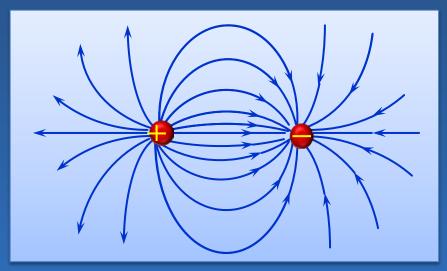
<u>电场线越密的地方,E</u> 越大。





静电场电场线的性质





三大性质:

- 电场线起于正电荷(或无限远处)终止于负电荷(或延伸向无限远处);
- ✓ 电场线不能形成闭合曲线;
- ✓ 任何两条电场线不相交:

二、电通量

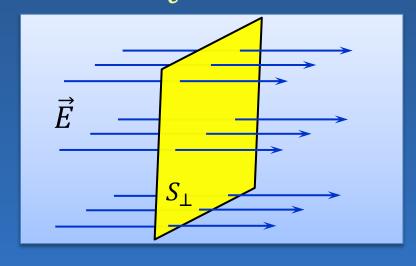
定义:通过某个面电场线的条数就是通过该面的电通量 Ψ_e

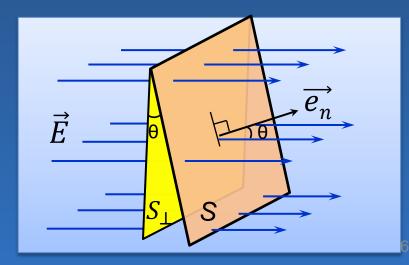
匀强电场: 若平面 S_{\perp} 与电场方向垂直,则 $\Psi_e = ES_{\perp}$

若平面S 与电场方向不垂直,引入面积矢量 \vec{S} , $\vec{S} = S \cdot \vec{e_n}$

由图可知:通过 S_{\perp} 和S面的电场线的条数相同,

$$\Psi_e = ES_{\perp} = EScos\theta$$
 $\Psi_e = \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{S}$





通过任意曲面的电通量?

把曲面S 分成无限多个面积元d \vec{s} ,每个无限小的面积元d \vec{s} 上的电场可以视为匀强电场,则通过该面元的电通量为:

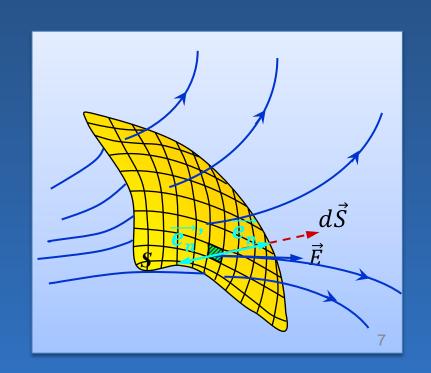
$$d\Psi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

对整个曲面积分可求得通过任意曲面S的电通量:

$$\Psi_e = \iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

若S为非闭合曲面,则面法线的 正方向可以取曲面的任一侧

正与负: 取决于面元的正法线方向的选取

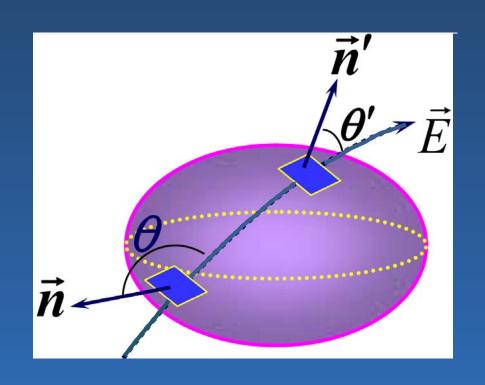


若S为闭合曲面,则
$$\Psi_e = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

规定: 自闭合面内指向面外的方向为面元的正法线方向

若电场线穿出, θ' 为锐角, $\vec{E} \cdot d\vec{S} > 0$ 若电场线穿入, θ 为钝角, $\vec{E} \cdot d\vec{S} < 0$

- ** 若 Ψ_e >0,穿出的电场线条数
- > 穿入的电场线条数
- ** 若 Ψ_e = 0,穿出的电场线条数 = 穿入的电场线条数
- $** 若 \Psi_e < 0$,穿出的电场线条数
- < 穿入的电场线条数



三、高斯定理

1. 表述

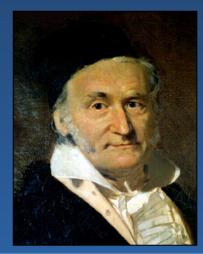
在真空静电场中,通过任意封闭曲面的电通量等于该封闭面所包围的电量的代数和的 $1/\epsilon_0$ 倍。

$$\oint \int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i} q_i$$

2. 高斯定理的证明

库仑定律+场强叠加原理

思路: 先证明单一点电荷的场, 然后推广至一般电荷分布的场



高斯(1777-1855) 德国数学家、物理 学家、天文学家

高斯定理的证明

通过以点电荷+q为球心,半径为r的球面的电通量:

电场具有球对称性,球面上E 处处相等, $d\vec{S}$ 与 \vec{E} 的夹角 θ =0

則:
$$\Psi_e = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

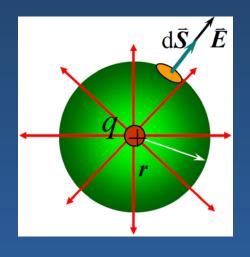
$$= \iint_S E \cdot dS \cdot \cos 0^\circ$$

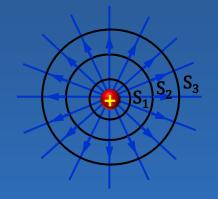
$$= \iint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot dS$$

$$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \iint_{S} dS$$

$$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$\Psi_e \alpha q$, 与球面半径无关!





高斯定理的证明

任一包含点电荷+q的闭合曲面, $\Psi_e = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \vec{E} \cdot d\vec{S}$

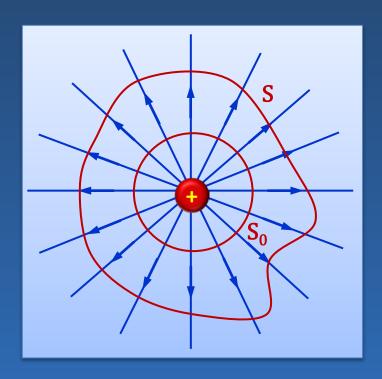


根据电场线模型:

$$\Psi_e = \iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \iint_{S_0} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \frac{q}{\varepsilon_0}$$



 $\Psi_e \alpha q$,与曲面形状无关!

高斯定理的证明

若任意曲面S不包围q, $\Psi_e = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = ?$

根据电场线模型:

穿入的电场线条数=穿出的电场线条数

$$\Psi_e = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$
$$= 0$$

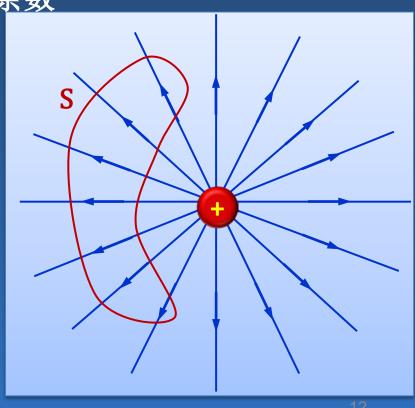
结论:

$$\Psi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} =$$

$$\frac{q}{\varepsilon_0}$$
 (S面包围 q)

0 (S面不包围q)

 $\Psi_e \alpha q_{in}$,与曲面形状无关!



高斯定理的证明

在有多个电荷的情况下, $\Psi_e = \bigoplus_{c} \vec{E} \cdot d\vec{S} = ?$

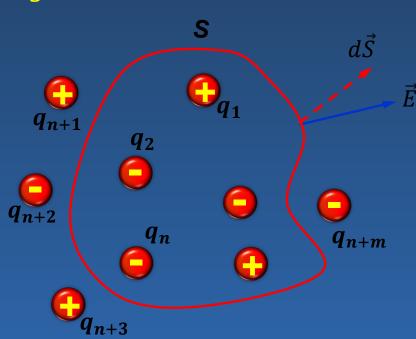
$$S$$
面内: $q_1, q_2 \dots q_n$

设
$$S$$
面内: $q_1, q_2 \dots q_n$ S 面外: $q_{n+1}, q_{n+2} \dots q_{n+m}$

根据场强叠加原理,

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n \\ + \vec{E}_{n+1} + \vec{E}_{n+2} + \dots + \vec{E}_{n+m}$$

$$\begin{split} \Psi_e &= \oiint_S \; \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \oiint_S \; \vec{E_1} \cdot d\vec{S} + \oiint_S \; \vec{E_2} \cdot d\vec{S} + \dots + \oiint_S \; \vec{E_n} \cdot d\vec{S} \\ &+ \oiint_S \; \vec{E}_{n+1} \cdot d\vec{S} + \oiint_S \; \vec{E}_{n+2} \cdot d\vec{S} + \dots + \oiint_S \; \vec{E}_{n+m} \cdot d\vec{S} \end{split}$$



高斯定理的证明

在有多个电荷的情况下,
$$\Psi_e = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = ?$$

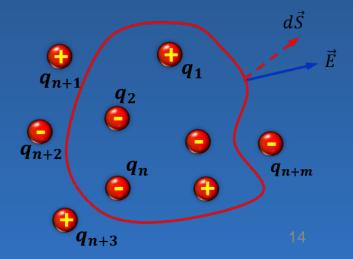
$$\Psi_e = \iint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \oiint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \dots + \oiint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{S}$$

$$+ \oiint_S \vec{E}_{n+1} \cdot d\vec{S} + \oiint_S \vec{E}_{n+2} \cdot d\vec{S} + \dots + \oiint_S \vec{E}_{n+m} \cdot d\vec{S}$$

$$= \frac{q_1}{\varepsilon_0} + \frac{q_2}{\varepsilon_0} + \dots + \frac{q_n}{\varepsilon_0} + 0$$

$$=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{i=1}^n q_i$$

只有S面内的电量对电通量有贡献!



在真空静电场中,通过任意封闭曲面S的电通量等于该曲面内电

量的代数和的 $1/\epsilon_0$ 倍,一般写为

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i} q_i$$

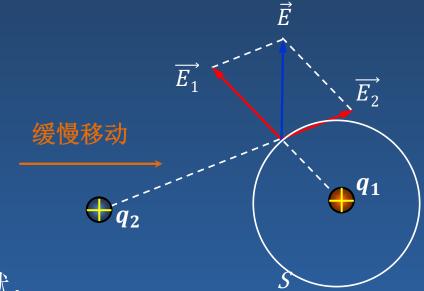
S面被称为高斯面



1.闭合面内、外电荷都对 \vec{E} 有贡献,

但只有闭合面内的电荷对∯_s E·dS有贡献

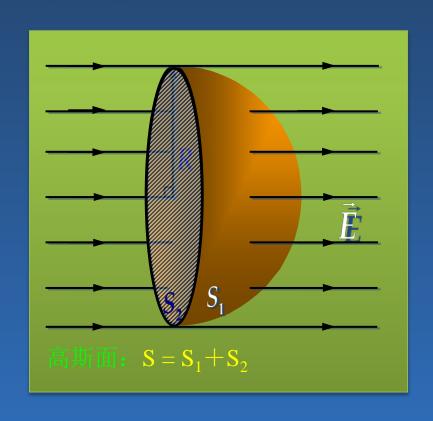
- 2.静电场性质的基本方程 有源场
- 3.源于库仑定律,高于库仑定律



例1 如图,均匀电场(电场强度为) Ē垂直与半径为 R 的半球面的底面,求通过该半球面的电通量。

解 作一辅助平面 S_2 ,则通过 $S_1+S_2=S$ 面的电通量:

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$



例1 如图,均匀电场(电场强度为) Ē垂直与半径为 R 的半球面的底面,求通过该半球面的电通量。

解 作一辅助平面 S_2 ,则通过 $S_1+S_2=S$ 面的电通量:

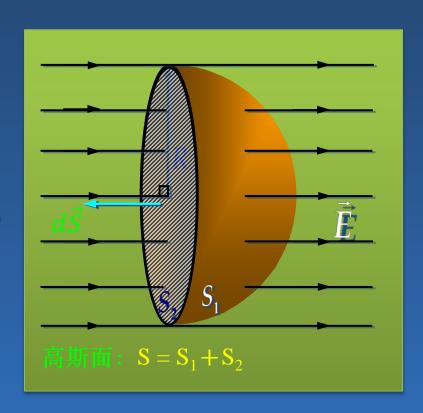
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\int_{S_{1}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{2}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

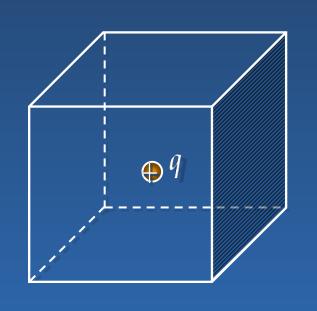
$$\int_{S_{1}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = -\int_{S_{2}} \vec{E} \cdot dS \cdot \cos 180^{\circ}$$

$$= E \int_{S_{2}} dS$$

$$= \pi E R^{2}$$



课堂练习如图,点电荷q位于立方体中心,求通过该立方体某一面的电通量。



提示:以立方体表面作为高斯面,则

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_{0}}$$

通过每个面的电通量相等!

$$\phi_{e} = \frac{q}{6\varepsilon_{0}}$$

高斯定理的应用--求对称场产

在实际求解的过程中,高斯定理往往用于计算具有高度对称性的静电场的场强

常见的高对称性的电荷分布

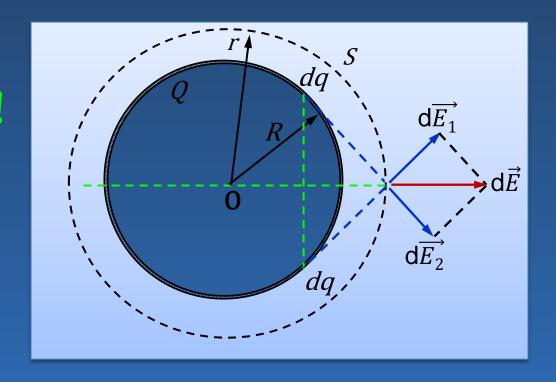
	球对称	轴对称	面对称
均匀带电的	球体 球面 点电荷	无限长柱体 无限长柱面 无限长带电线	无限大平板 无限大平面

基本思路:对于球/柱/面对称性电场,选择适当的高斯面 S,使得高斯面上各点的 \vec{E} 大小相等,方向与高斯面法线有固定夹角

 \overline{M} 2. 求总电量为Q、半径为R的均匀带电球面的电场强度分布

分析: 在半径为r的同心球面上 \vec{E} 大小相等,方向垂直于球面

球对称!



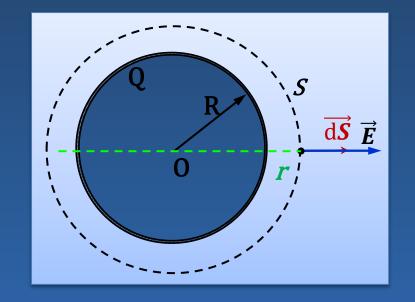
\overline{M} 2. 求总电量为Q、半径为R的均匀带电球面的电场强度分布

解:由于 \vec{E} 具有球对称分布,取以O为球心,r为半径的球面为高斯面S

$$\Psi_e = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \iint_S E dS \cdot \cos 0^\circ$$

$$= E \iint_S dS = E 4\pi r^2$$



根据高斯定理:

$$E 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i} q_i \longrightarrow E = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \sum_{i} q_i$$

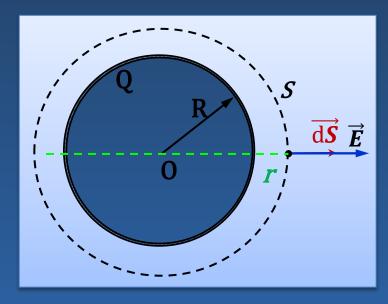
\overline{M} 2. 求总电量为Q、半径为R的均匀带电球面的电场强度分布

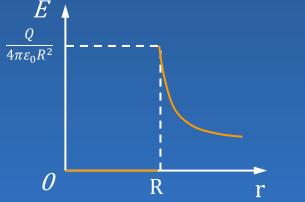
$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \sum_i q_i$$

高斯面内电量代数和:

$$r < R$$
时, $\sum q_i = 0$ $r > R$ 时, $\sum q_i = Q$

$$E = \begin{bmatrix} 0 & (r < R) \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (r > R) \end{bmatrix}$$





高斯定理的应用-求对称场层

步骤

- 1. 电场的对称分析
- 2. 选取适当高斯面
- 3. 计算电通量
- 4. 让它等于面内电荷代数和的1/ε₀

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i} q_i$$

关键在于: 高斯面的选取

- (1) 选规则闭合曲面
- (2) 所有面必须满足以下条件之一:
 - ✓ \vec{E} 为常量,且 \vec{E} 和 $d\vec{S}$ 间有固定夹角
 - ✔ 电场强度垂直于闭合面,大小可以不相等
 - $\checkmark \vec{E} = \mathbf{0} \vec{x} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \mathbf{0}$

例3. 求均匀带电球体的场强分布。(已知球体半径为R,带电量为q,电荷密度为 ρ)

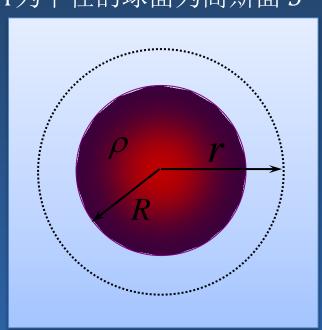
解:由于 \vec{E} 具有球对称分布,取以O为球心,r为半径的球面为高斯面S

$$\Psi_e = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$
$$= E \iint_S dS = E 4\pi r^2$$

根据高斯定理:

$$E 4\pi r^{2} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{i} q_{i}$$

$$E = \frac{1}{4\pi \varepsilon_{0} r^{2}} \sum_{i} q_{i}$$



(1) 球外某点的场强 $q = \rho \frac{4}{3}\pi R^3$

$$q = \rho \frac{4}{3} \pi R^3$$

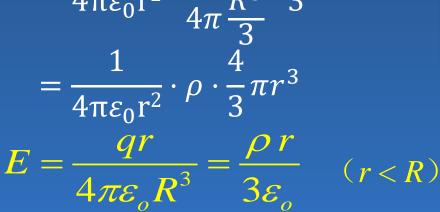
$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \sum_{i} q_i$$
$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad (r \ge R)$$

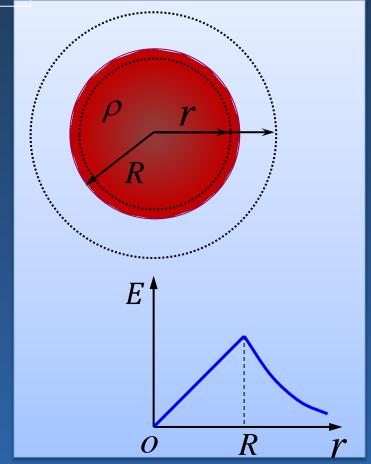
(2) 球体内某点的场强

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \sum_{i} q_i$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \frac{q}{4\pi \frac{R^3}{3}} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$$





例4. 计算无限大均匀带电平面的场强分布。

(电荷密度为 σ)

解:取相对于平面呈对称分布的圆柱体闭合面为高斯面

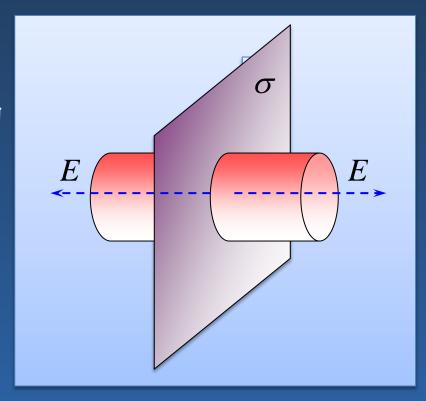
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot \mathbf{d}\vec{S} = 2\Phi_{\mathbf{k}} + \Phi_{\mathbf{m}}$$

$$2\Phi_{\mathbb{R}} = 2ES$$

$$\Phi_{\emptyset} = 0$$

由高斯定理:
$$2ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_o}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon}$$
 方向: $\sigma > 0$,垂直于平面并指向平面外 $\sigma < 0$,垂直指向平面



例5. 计算两无限大均匀带异号电荷平面的场强分布。

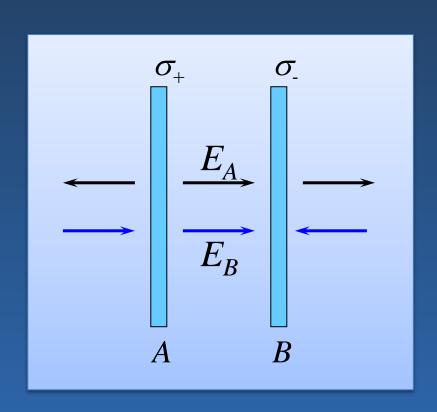
解:
$$E_A = E_B = \frac{\sigma}{2\varepsilon_o}$$

平面之间:

$$E_{\text{pl}} = E_A + E_B = \frac{\sigma}{\varepsilon_o}$$

两平面外侧:

$$E_{\text{bh}} = E_A - E_B = 0$$



例6. 求无限长带电直线的场强分布。(已知线电荷密度为*λ*)

解:取以带电直线为对称轴的圆柱体面为高斯面

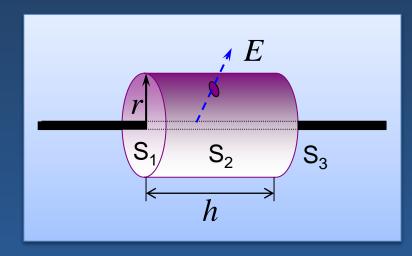
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot \mathbf{d}\vec{S} = \frac{\sum q_{i}}{\varepsilon_{o}}$$

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot \mathbf{d}\vec{S} = \Phi_{1} + \int_{S_{2}} E \mathbf{d}S + \Phi_{3}$$

$$\Phi_1 = \Phi_3 = 0$$

$$\int_{S_2} E \cdot \mathbf{d}S = E \cdot 2\pi \, rh$$

$$E \cdot 2\pi \, rh = \frac{\lambda \, h}{\varepsilon_o} \longrightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_o r}$$



例7. 求无限长均匀带电圆柱面的电场分布

单位长度圆柱面的带电量为 λ

解: 取与带电圆柱面同轴的圆柱体面 为高斯面

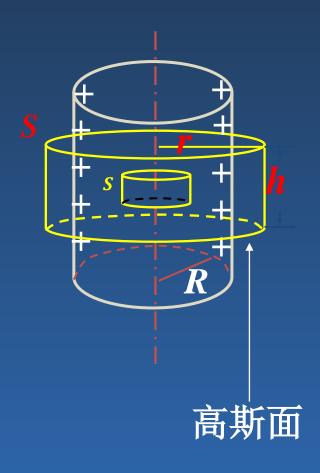
$$\Phi_{e} = \int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{Min} E \, dS$$

$$= E \cdot 2\pi \, rh,$$

(1) 柱面外, r>R

$$\sum q_i = \lambda h$$
 , $E_{fh} = \frac{\lambda}{2\pi \, \varepsilon_0 r}$ (2) 柱面内, $r < R$

$$\sum q_i = 0$$
, $E_{\bowtie} = 0$



★ 结论: 无限长均匀带电圆柱面的场强

$$E = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi \, \varepsilon_0 \, r} & (r > R) & \frac{\lambda}{2\pi \, \varepsilon_0 \, R} \end{cases}$$

$$(r < R) \quad (r < R)$$

- (1) 圆柱面外的场强
 - = 把电量集中于轴线上的无限长均匀带电直线的场强;
- (2) 圆柱面内的场强处处 = 0。



例8 有一带球壳,内外半径分别为a和b,电荷密度 ρ =A/r,在球心处有一点电荷 Q,证明当 $A = Q/2\pi a^2$ 时,球壳区域内的场强 E的大小与r无关。

 $4\pi r'^2 dr'$

证明:

以 Q 为圆心,半径 r 作一球面 为高斯面,则利用高斯定理与场 分 布具有球对称性的特点可得

$$\int \vec{E} \cdot d\vec{S} = E4\pi r^2 = \frac{Q + \int \rho \, dV}{\varepsilon_0} \quad \dots (1)$$

$$\int \rho \ dV = \int_{a}^{r} \frac{A}{r'} 4\pi \ r'^{2} dr' = 2\pi A(r^{2} - a^{2}) \, \text{代} \lambda \quad (1)$$

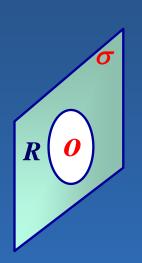
$$E = \frac{Q}{4 \pi \varepsilon_0 r^2} + \frac{A}{2\varepsilon_0} - \frac{Aa^2}{2 \varepsilon_0 r^2} = \frac{A}{2\varepsilon_0} + (\frac{Q}{4 \pi \varepsilon_0} - \frac{Aa^2}{2 \varepsilon_0}) \frac{1}{r^2}$$

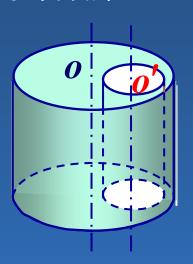
$$\stackrel{\cong}{=} A = \frac{Q}{2\pi a^2} \qquad E = \frac{A}{2\varepsilon_0}$$



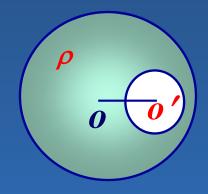
利用场强叠加原理,求如下带电体的电场分布:

- 1. 带小缺口的细圆环 O 处的场强;
- 2. 带圆孔的无限大平板 O 处的场强;
- 3. 带有空腔的圆柱体O'处的场强;
- 4. 带有空腔的球体 0′处的场强。









总结

- 1. **电场线模型**: 电场线上任一点的切线方向为该点的电场方向,电场线密度为电场强度。
- 2. 电通量: $\Psi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$
- 3. 高斯定理: 通过闭合曲面S的电通量和作为场源的电荷量q之间的关系。

证明:
$$\iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i} q_i$$

应用: 求解对称场中的 \vec{E}